# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### MACHINE-ASSISTED TRANSLATION (MAT):

(19)【発行国】 日本国特許庁(JP) (19)[ISSUING COUNTRY] Japanese Patent Office (JP)

(12)【公報種別】 公開特許公報 (A)

Laid-open (kokai) patent application number (A)

(11)【公開番号】 特開平10-88120 (11)[UNEXAMINED PATENT NUMBER] Unexamined Japanese patent No. 10-88120

(43)【公開日】 平成10年(1998)4月7 日

(43)[DATE OF FIRST PUBLICATION] April 7th, Heisei 10 (1998)

(54)【発明の名称】 素子

(54)[TITLE] 有機エレクトロルミネッセンス An organic electroluminescent element

(51)【国際特許分類第6版】 C09K 11/06

Z

(51)[IPC] C09K 11/06

[FI] C09K 11/06 [FI] C09K 11/06

【審査請求】 未請求

[EXAMINATION REQUEST] UNREQUESTED

【請求項の数】

[NUMBER OF CLAIMS]

【出願形態】 OL

[Application form] OL

【全頁数】 20 [NUMBER OF PAGES] 20

(21)【出願番号】 特願平8-244490 (21)[APPLICATION NUMBER] Japanese Patent Application No. 8-244490

(22)【出願日】 平成8年(1996)9月17

(22)[DATE OF FILING] September 17th, Heisei 8 (1996) (71)【出願人】

(71)[PATENTEE/ASSIGNEE]

【識別番号】

000222118

[ID CODE] 000222118

【氏名又は名称】

東洋インキ製造株式会社

Toyo Ink Mfg. Co., Ltd.

【住所又は居所】

東京都中央区京橋2丁目3番13号

[ADDRESS]

(72)【発明者】

(72)[INVENTOR]

【氏名】 奥津 聡

Satoshi Okutsu

【住所又は居所】

東京都中央区京橋二丁目3番1 3号 東洋インキ製造株式会社 内 [ADDRESS]

(72)【発明者】

(72)[INVENTOR]

【氏名】 鬼久保 俊一

Shunichi Onikubo

【住所又は居所】

東京都中央区京橋二丁目3番1 3号 東洋インキ製造株式会社 内 [ADDRESS]

(72)【発明者】

(72)[INVENTOR]

【氏名】 榎田 年男

Toshio Enokida

【住所又は居所】

東京都中央区京橋二丁目3番1 3号 東洋インキ製造株式会社 内 [ADDRESS]

(C) DERWENT

【氏名】 玉野 美智子

Michiko Tamano

【住所又は居所】

[ADDRESS]

東京都中央区京橋二丁目3番1 3号 東洋インキ製造株式会社 内

(57)【要約】

(57)[SUMMARY]

#### 【課題】

発光劣化が少なく信頼性の高い エレクトロルミネッセンス素子 を提供することを課題とする。

#### 【解決手段】

I p a < I p h 1 < I p h 2 < I p h 3 < · · · < I p h m < I p e

I p e

の関係を有し、かつ発光層に下
記一般式 [1] で示される化合
物を含有してなる有機エレクト
ロルミネッセンス素子。
一般式 [1]

【化1】

#### [SUBJECT]

It subjects providing an electroluminescent element few light-emission degradation and reliable.

#### [SOLUTION]

It is sequentially to laminate an anode, the hole injection layer which consists of an m (m shows integer of 2-10) layer, an emitter layer, an electron injection layer, and a cathode.

When setting to lph1, lph2, and lph3\*\*\*lphm from an anode the value of the ionization potential of a hole injection layer at order, Between the ionization potential of the each layer of this hole injection layer, the value (lpa) of the work function of an anode, and the value (lpe) of the ionization potential of an emitter layer It has the relationship of the following formula lpa<lph1<lph2<lph3<\*\*\*<lphm<lp>lphm<lpe.</li>

And the organic electroluminescent element which contains the compound shown in an emitter layer by the following general formula [1].

General formula [1]

[COMPOUND 1]

$$A^{1}$$
  $N-Z-N$   $A^{3}$   $A^{4}$ 

[式中、環A¹~A⁴は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換の複素環基を表す。 Zは、炭素数30以下からなる置換もしくは未置換の縮合アリール基または縮合アリール複素環基を表す。]

【特許請求の範囲】

[ In the formula, ring A1- A4 respectively shows independently a substituted or non-substituted aryl group and a substituted or non-substituted heterocyclic group.

Z shows the substituted or non-substituted condensation aryl group which consists of 30 or less carbon number, or a condensation aryl heterocyclic group.]

#### [CLAIMS]

#### 【請求項1】

陽極、m (mは2~10の整数を表す)層からなる正孔注入層、発光層、電子注入層及び陰極を順次積層してなり、正孔注入層のイオン化ポテンシャルの値を見ります。 Iph3・・・『Iphmとしたとき、該正孔注入層の各層のイオン化ポテンシャルと、陽極の仕事関数の値(Ipa)と、発光層のイオン化ポテンシャルの値(Ipe)との間に以下の式

Ipa<Iph1<Iph2<Iph2<Iph3<・・・<Iphm<Ipeの関係を有し、かつ発光層に下記一般式[1]で示される化合物を含有してなる有機エレクトロルミネッセンス素子。

一般式[1]

#### **[CLAIM 1]**

It is sequentially to laminate an anode, the hole injection layer which consists of an m (m shows integer of 2-10) layer, an emitter layer, an electron injection layer, and a cathode.

When setting to lph1, lph2, and lph3\*\*\*lphm from an anode the value of the ionization potential of a hole injection layer at order, Between the ionization potential of the each layer of this hole injection layer, the value (lpa) of the work function of an anode, and the value (lpe) of the ionization potential of an emitter layer It has the relationship of the following formula lpa<lph1<lph2<lph3<\*\*\*<lp>lphm<lpe.</li>

And the organic electroluminescent element which contains the compound shown in an emitter layer by the following general formula [1].

General formula [1]

【化1】

[COMPOUND 1]

$$A^{1}$$
  $N-Z-N$   $A^{3}$   $A^{4}$ 

[式中、環A¹~A⁴は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換の複素環基を表す。 Zは、炭素数30以下からなる置換もしくは未置換の縮合アリール基または縮合アリール複素環基を表す。]

#### 【請求項2】

一般式[1]の化合物が下記一般式[2]の化合物である請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

一般式 [2]

【化2】

[ In the formula ring A1- A4 respectively shows independently a substituted or non-substituted aryl group and a substituted or non-substituted heterocyclic group.

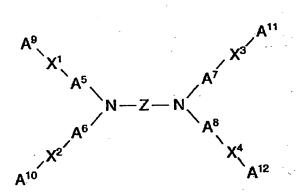
Z shows the substituted or non-substituted condensation aryl group which consists of 30 or less carbon number, or a condensation aryl heterocyclic group.]

#### [CLAIM 2]

The organic electroluminescent element of the Claim 1 whose compound of a general formula [1] is a compound of the following general formula [2].

General formula [2]

[COMPOUND 2]



[式中、 $A^5\sim A^8$  は、それぞれ [ In the formula, A5 - A8 respectively show

独立に、置換もしくは未置換の アリーレン基、置換もしくは未 置換の2価の複素環基を表す。  $A^9 \sim A^{12}$  は、それぞれ独立に、 置換もしくは未置換のアリール 基、置換もしくは未置換の複素 環基を表す。 Zは、炭素数30 以下からなる置換もしくは未置 換の縮合アリール基または縮合 アリール複素環基を表す。X1 ~ X⁴ は、それぞれ独立に、-O-, -S-, >C=O, >S $O_2$ , >C=S, >C=(CN) $_{2}$ , > C = S = O, > C = N - O $CN \setminus C = N - R^1 \mid (R^1 i \downarrow L)$ 水素原子、ハロゲン原子、置換 もしくは未置換のアリール基、 置換もしくは未置換のシクロア ルキル基、置換もしくは未置換 の複素環基を表す。)、(CH。) <sub>x</sub>-O- (CH<sub>2</sub>) 、(xおよび yは、それぞれ独立に0~20 の正の整数を表すが、x+y= 0となることはない)、置換もし くは未置換のアルキレン基、置 換もしくは未置換のシクロアル キレン基を表す。]

【請求項3】

mが2である請求項1または2 記載の有機エレクトロルミネッ センス素子。

#### 【請求項4】

発光層のイオン化ポテンシャルの値(Ipe)が5.2~6.0である請求項1ないし3いずれか記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

independently a substituted or non-substituted arylene group and a substituted or non-substituted bivalent heterocyclic group.

A9-A12 respectively show independently a substituted or non-substituted aryl group and a substituted or non-substituted heterocyclic group.

Z shows the substituted or non-substituted condensation aryl group which consists of 30 or less carbon number, or a condensation aryl heterocyclic group.

X1- x4 are independent respectively, -O-,-S-,>C=O,>SO2,>C=S,>C=(CN)2,>C=S=O,>C=N-CN,>C=N-R1 (R1 shows a hydrogen atom, a halogen atom, a substituted or non-substituted aryl group, a substituted or non-substituted cycloalkyl group, and a substituted or non-substituted heterocyclic group.)

(CH2)x-O-(CH2)y (x and y respectively show the positive integer of 0-20 independently.

However, it is not become x+y=0.) A substituted or non-substituted alkylene group and a substituted or non-substituted cycloalkylene group are shown.]

**ICLAIM 31** 

The organic electroluminescent element of the Claim 1 or 2 whose m is 2.

**ICLAIM 41** 

The value (lpe) of the ionization potential of an emitter layer is 5.2-6.0. An organic electroluminescent element described in either of Claim 1 to 3.

[DETAILED DESCRIPTION OF INVENTION]

[0001]

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は平面光源や表示、通信 用光源に使用される有機エレク トロルミネッセンス(EL)素 子に関するものである。

[0002]

#### 【従来の技術】

有機物質を使用したEL素子 は、固体発光型の安価な大面積 フルカラー表示素子としての用 途が有望視され、多くの開発が 行われている。一般にELは、 発光層および該層をはさんだ一 対の対向電極から構成されてい る。発光は、両電極間に電界が 印加されると、陰極側から電子 が注入され、陽極側から正孔が 注入される。さらに、この電子 が発光層において正孔と再結合 し、エネルギー準位が伝導帯か ら価電子帯に戻る際にエネルギ ーを光として放出する現象であ る。

#### [0003]

従来の有機EL素子は、無機E し素子に比べて駆動電圧が高 く、発光輝度や発光効率も低か った。また、特性劣化も著し 実用化には至っていなかった。 近年、10V以下の低電圧で発 光する高い蛍光量子効率を持った 有機化合物を含有した薄膜と 積層した有機EL素子が報告され、関心を集めている(アプラ

#### [TECHNICAL FIELD]

This invention relates to the organic electroluminescence (EL) element used for a flat light source, or a display, and a communications light source.

[0002]

#### [PRIOR ART]

The EL element which used organic compound, the application as an inexpensive large area full-colour display device of a solid-state light-emission type promising-looks, is performed, and many development is performed.

EL consists of a pair of counter electrode which sandwiched the emitter layer and this layer, generally.

If an electric field is impressed between both electrodes, an electron will be injected from a cathode side and, as for a light emission, a hole will be injected from an anode side.

Furthermore, this electron recombines with a hole in an emitter layer.

It is the phenomenon which discharges an energy as a light, in the case an energy level returning from a conduction band to a valence band.

#### 100031

The conventional organic EL element has a high drive voltage compared with an inorganic EL element. The light-emission brightness and the luminous efficiency were also low.

Moreover, characteristic degradation remarkably, had not arrived in utilisation either. In recent years, the organic EL element which laminated the thin film which contained the organic compound with the fluorescent high quantum efficiency which emits light by the 10 V or less low voltage is reported, and interests are collected.

イド・フィジクス・レターズ、51巻、913ページ、1987年参照)。この方法では、金属キレート錯体を蛍光体層、アまれ合物を正孔注入層に使用して、高輝度の緑色発光を得取を発光をでは100cd/m²、最大発光効率は1.51m/Wを達成して、実用領域に近い性能を持っている。

#### [0004]

有機EL素子の構造としてはこ れまでに2層構造(陽極と陰極 の間に、ホール注入層と電子注 入性発光層が形成された構造ま たは、陽極と陰極の間に、ホー ル注入性発光層と電子注入層が 形成された構造)、あるいは3層 構造 (陽極と陰極の間にホール 注入層と発光層と電子注入層と が形成された構造) がある。し かしながら、現在までの有機E L素子は、構造の改善により発 光強度は改良されているが、繰 り返し使用時の安定性に劣ると いう大きな問題を持っている。 従って、繰り返し使用時での安 定性の優れた有機EL素子の開 発のためには、更なる素子構造 の改善が必要である。

[0005]

【発明が解決しようとする課 題】

本発明の目的は、陽極と陰極の 間に、ホール注入層と発光層と 電子注入層が形成された構造の

(Refer applied \* physics \* letters, 51 volumes, 913 pages, 1987).

By this procedure, a metal chelate complex is used for a fluorescent layer, and an amine group compound is used for a hole injection layer.

The green light emission of a high-intensity has been obtained.

It is the DC voltage of 6-7V, and brightness is 100 cd/m2. A maximum luminous efficiency attains 1.5lm/W.

It has the performance near a practical-use area.

#### [0004]

As a structure of an organic EL element, there is a 2 layer structure (structure where the hole injection layer and the electron injection property emitter layer were formed between the anode and the cathode, or structure where the hole injection property emitter layer and the electron injection layer were formed between the anode and the cathode). Or there is a 3 layer structure (structure where the hole injection layer, the emitter layer, and the electron injection layer were formed between the anode and the cathode) hitherto.

However, light-emission strength is improved the organic EL element by present by improvement of the structure.

However, it has the large problem that it is inferior to the stability at the time of repeating usage.

Therefore, because of development of the organic EL element which was outstanding in the stability in the time of repeating usage, the further element structure needs to be improved.

[0005]

#### [PROBLEM ADDRESSED]

The objective of this invention, In the organic electroluminescent element of the structure where the hole injection layer, the emitter layer, and the electron injection layer were formed between the anode and the cathod It aims at

有機エレクトロルミネッセンス 素子において、陽極とホール注 入層の間に複数層のホール注入 層を挿入することにより、発光 輝度が大きく、繰り返し使用時 での安定性の優れた有機EL素 子を提供することを目的とす る。 providing the organic EL element which the light-emission brightness was large and was outstanding in the stability in the time of repeating usage by inserting a multiple layered hole injection layer between an anode and a hole injection layer.

[0006]

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、陽極、m(mは2~10の整数を表す)層からなる正孔注入層、発光層、電子注入層及び陰極を順次積層してポンシャルの値を陽極から順に1phmとしたとき、記孔注入層の各層のイオン化事関数の値(Iphmと、陽極の仕事関数の値(Ipa)と、発光層のイオン化の間に以下の式

I p a < I p h 1 < I p h 2 < I p h 3 < · · · < I p h m < I p e

の関係を有し、かつ発光層に下 記一般式 [1] で示される化合 物を含有してなる有機エレクト ロルミネッセンス素子である。 一般式 [1]

【化3】

This invention is sequentially to laminate an anode, the hole injection layer which consists of an m (m shows integer of 2-10) layer, an emitter layer, an electron injection layer, and a cathode.

**ISOLUTION OF THE INVENTION** 

When setting to lph1, lph2, and lph3\*\*\*lphm from an anode the value of the ionization potential of a hole injection layer at order, Between the ionization potential of the each layer of this hole injection layer, the value (lpa) of the work function of an anode, and the value (lpe) of the ionization potential of an emitter layer It has the relationship of the following formula lpa<lph1<lph2<lph3<\*\*\*<lp>hm<lpe.</p>

And it is the organic electroluminescent element which contains the compound shown in an emitter layer by the following general formula [1].

General formula [1]

[COMPOUND 3]

 $A^{1}$  N-Z-N  $A^{3}$   $A^{4}$ 

[式中、環A¹~A⁴は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換の変素環基を表す。 Zは、炭素数30以下からなる置換もしくは未置換の縮合アリール基または縮合アリール複素環基を表す。]

[ In the formula Ring A1- A4 respectively shows independently a substituted or non-substituted aryl group and a substituted or non-substituted heterocyclic group.

Z shows the substituted or non-substituted condensation aryl group which consists of 30 or less carbon number, or a condensation aryl heterocyclic group.]

#### [0007]

更に本発明は、一般式[1]の 化合物が下記一般式[2]の化 合物である請求項1記載の有機 エレクトロルミネッセンス素子 である。

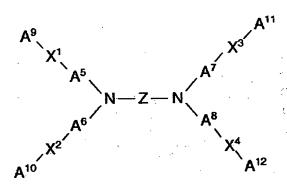
一般式 [2]

【化4】

#### [0007]

Furthermore this invention is the organic electroluminescent element of the Claim 1 whose compound of a general formula [1] is a compound of the following general formula [2]. General formula [2]

#### [COMPOUND 4]



[式中、 $A^5 \sim A^8$  は、それぞれ 独立に、置換もしくは未置換の アリーレン基、置換もしくは未 置換の 2 価の複素環基を表す。  $A^9 \sim A^{12}$  は、それぞれ独立に、 置換もしくは未置換のアリール 基、置換もしくは未置換の複素 [ In the formula A5 - A8 respectively show independently a substituted or non-substituted arylene group and a substituted or non-substituted bivalent heterocyclic group.

A9 - A12 respectively show independently a substituted or non-substituted aryl group and a substituted or non-substituted heterocyclic group.

# HOMSON SCIENTIFIC

環基を表す。2は、炭素数30 以下からなる置換もしくは未置 換の縮合アリール基または縮合 アリール複素環基を表す。X<sup>1</sup> ~ X <sup>4</sup> は、それぞれ独立に、-O-, -S-, > C=O, > S $O_2$ , >C=S, >C=(CN), > C = S = O, > C = N - $CN \setminus C = N - R^{1} (R^{1} l)$ 水素原子、ハロゲン原子、置換 もしくは未置換のアリール基、 置換もしくは未置換のシクロア ルキル基、置換もしくは未置換 の複素環基を表す。)、(CH2) <sub>x</sub> -O-(CH<sub>2</sub>)、(x および yは、それぞれ独立に0~20 の正の整数を表すが、x+y= 0となることはない)、置換もし くは未置換のアルキレン基、置 換もしくは未置換のシクロアル キレン基を表す。]

[0008]

更に本発明は、mが2である上 記有機エレクトロルミネッセン ス素子である。更に本発明は、 発光層のイオン化ポテンシャル の値 (Ipe) が5.3~6. 0である上記有機エレクトロル ミネッセンス素子である。

#### 【発明の実施の形態】

#### [0009]

有機EL素子は、陽極と陰極間 に一層もしくは多層の有機薄膜 を形成した素子である。一層型 の場合、陽極と陰極との間に発 光層を設けている。多層型は、

(陽極/正孔注入層/発光層/

Z shows the substituted or non-substituted condensation aryl group which consists of 30 or less carbon number, or a condensation aryl heterocyclic group.

X1- x4, are independent respectively. -O-,-S-, >C=O,>SO2 ,>C=S,>C=(CN)2 , >C=S=O,>C=N-CN,>C=N-R1 (R1 shows a hydrogen atom, a halogen atom, a substituted or non-substituted aryl group, a substituted or cycloalkyl group, non-substituted non-substituted heterocyclic substituted or group.)

(CH2) x-O-(CH2) y (x and y respectively show the positive integer of 0-20 independently

However, it does not become x+y=0.) A substituted or non-substituted alkylene group non-substituted substituted or а cycloalkylene group are shown.

#### [8000]

Furthermore this invention is an above organic electroluminescent element whose m is 2.

Furthermore this invention is an above organic electroluminescent element whose value (Ipe) of the ionization potential of an emitter layer is 5.3-6.0.

#### [Embodiment]

#### [0009]

An organic EL element is an element which formed one layer or the multilayer organic thin film between the anode and the cathode.

In the case of one-layer type the emitter layer is provided between the anode and the

A multilayer type has the organic EL element 陰極)、(陽極/発光層/電子注 laminated with the multilayer component of (an 入層/陰極)、(陽極/正孔注入 層/発光層/電子注入層/陰 極)の多層構成で積層した有機 E L素子がある。

[0010]

従来の多層型有機EL素子の場 合、陽極から発光層へのホール 注入障壁が大きく、ジュール熱 による有機層の結晶化を引き起 こし、耐久性に問題があった。 本発明では、一対の電極間に複 数層の正孔注入層、発光層、電 子注入層からなるエレクトロル ミネッセンス素子において、前 記式(I)の関係を満足するよ うに陽極と発光層の間に複数の ホール注入層を挿入することに より、ホール注入障壁を低下す ることができるため、有機EL 素子の耐久性の向上を図ること が可能になる。本発明のホール 注入障壁とは各層のイオン化ポ テンシャルの差を意味し、イオ ン化ポテンシャルとは、金属電 極薄膜、半導体電極薄膜、及び 有機薄膜から電子を1個引き抜 くために必要なエネルギーを意 味し、本発明では大気雰囲気型 紫外線光電子分析装置(表面分 析装置AC-1:理研計器(株)) によって評価を行った。また、 本発明の有機EL素子は、正孔 注入層が前記式(I)の関係を 満足していれば、電子注入層は 複数の層から構成されていても 良い。

[0011]

以下に本発明の有機EL素子を 構成する好ましい材料について

anode / hole injection layer / emitter layer / cathode), (an anode / emitter layer / electron injection layer / cathode), and (an anode / hole injection layer / emitter layer / electron injection layer / cathode).

#### [0010]

In the case of the conventional multilayer type organic EL element, from an anode, the hole injection barrier to an emitter layer is large, and the crystallization of the organic layer due to a Joule heat is caused.

There was a problem durable.

With this invention, In the electroluminescent element which consists of a multiple layered hole injection layer, an emitter layer, and an electron injection layer between a pair of electrodes A hole injection barrier can be reduced by inserting several hole injection layers between an anode and an emitter layer so that the relationship of an above-mentioned formula (I) may be satisfied. Therefore, the durable improvement in an organic EL element can be achieved.

The hole injection barrier of this invention represents the difference of the ionization potential of each layer. Ionization potential represents an energy required in order to extract 1 electron from a metal-electrode thin film, a semiconductor-electrode thin film, and an organic thin film.

In this invention it evaluated by the atmosphiric-condition type ultraviolet linear-light electron analyser (surface-analysis apparatus AC-1: Riken Keiki Co., Ltd.).

Moreover, the organic EL element of this invention, As long as the hole injection layer has satisfied the relationship of an above-mentioned formula(I), the electron injection layer may consist of several layers.

1 5 )

[0011]

It describes below about a desirable material which comprises the organic EL element of this invention.

12 - 12 I

記す。発光材料としては、上記一般式 [1]で示される材料を用いる。一般式 [1]中の Z は、炭素数 3 0 以下からなる置換もしくは未置換の縮合アリール基または縮合アリール複素環基を表し、具体例としては以下のシリール化合物の残基が挙げられる。

As a luminescent material, the material shown by the above general formula [1] is used. Z in a general formula [1] shows the substituted or non-substituted condensation aryl group which consists of 30 or less carbon number, or a condensation aryl heterocyclic group. The residue of the following aryl compounds is mentioned as an example.

[0012]

[0012]

【表1】

[Table 1]

[表]]			
(1)		(911	
(2)		(1 0)	r√N →
(3)		:11)	
(4)	Ø	(12)	
(5)	Q <sub>s</sub> Q <sub>s</sub>		~~
(6)	00	£1 3)	mg
(7)		(14)	m
(8)		(15)	00000

[0013]

[0013]

13/45

13:11	
(1.61	
(17)	
(18)	
(19)	
(20)	8:8
(21)	

(0.0)	
(23)	08

#### [0014]

一般式[1]中の2への置換基 の具体的な例を挙げると、塩素、 臭素、ヨウ素、フッ素のハロゲ ン原子、メチル基、エチル基、 プロピル基、ブチル基、sec ーブチル基、tertープチル 基、ペンチル基、ヘキシル基、 ヘプチル基、オクチル基、ステ アリル基、トリクロロメチル基 等のアルキル基、フェニル基、 トリル基、ナフチル基、ビフェ ニル基、o, m, p-ターフェ ニル基、アントラニル基、フェ ナントレニル基、フルオレニル 基、9-フェニルアントラニル 基、9、10-ジフェニルアン トラニル基、ピレニル基等のア リール基、n-ブトキシ基、t ertープトキシ基、トリクロ ロメトキシ基、トリフルオロエ トキシ基、ペンタフルオロプロ ポキシ基、2,2,3,3-テ トラフルオロプロポキシ基、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフ ルオロー2ープロポキシ基、6

#### [0014]

If the concrete example of the substituent group to Z in a general formula [1] is given, alkyl groups, such as the halogen atom of chlorine, a bromine, an iodine, and a fluorine, a methyl group, an ethyl group, a propyl group, a butyl group, sec-butyl group, tert-butyl group, a pentyl group, a hexyl group, a heptyl group, an octyl group, a stearyl group, and a trichloro methyl group, aryl groups, such as a phenyl group, a tolyl group, a naphthyl group, a biphenyl group, o and m, p-terphenyl group, an anthranil group, a phenanthrenyl group, a fluorenyl group, 9phenyl anthranil group, 9, 10-diphenyl anthranil group, and a pyrenyl group, n-butoxy group, tert-butoxy group, A trichloro methoxy group, a trifluoro ethoxy group, a pentafluoro propoxy group, 2,2,3,3-tetrafluoro propoxy group, a 1,1,1,3,3,3-hexafluoro- 2- propoxy group, 6-(perfluoro ethyl) hexyloxy group Alkoxy groups, such as above, Aryloxy groups, such as a phenoxy group, p- Nitro phenoxy group, a ptert-butyl phenoxy group, 3- fluoro phenoxy group, a pentafluoro phenyl group, and 3trifluoromethyl phenoxy group, alkylthio groups, such as a methylthio group, an ethylthio group, tert-butylthio group, a hexyl thio group, an octyl thio group, and a trifluoro methylthio group, Arylthio groups, such as a phenylthio group, p-

シルオキシ基等のアルコキシ 基、フェノキシ基、pーニトロ フェノキシ基、p-tert-ブチルフェノキシ基、3-フル オロフェノキシ基、ペンタフル オロフェニル基、3ートリフル オロメチルフェノキシ基等のア リールオキシ基、メチルチオ基、 エチルチオ基、tertーブチ ルチオ基、ヘキシルチオ基、オ クチルチオ基、トリフルオロメ チルチオ基等のアルキルチオ 基、フェニルチオ基、pーニト ロフェニルチオ基、p-ter t-ブチルフェニルチオ基、3 ンタフルオロフェニルチオ基、 3-トリフルオロメチルフェニ ルチオ基等のアリールチオ基、 シアノ基、ニトロ基、アミノ基、 メチルアミノ基、ジエチルアミ ノ基、エチルアミノ基、ジエチ ルアミノ基、ジプロピルアミノ 基、ジブチルアミノ基、ジフェ ニルアミノ基等のモノまたはジ 置換アミノ基、ビス(アセトキ シメチル) アミノ基、ビス (ア セトキシエチル) アミノ基、ビ スアセトキシプロピル) アミノ 甚、ビス (アセトキシブチル) アミノ基等のアシルアミノ基、 水酸基、シロキシ基、アシル基、 メチルカルバモイル基、ジメチ ルカルバモイル基、エチルカル バモイル基、ジエチルカルバモ イル基、プロイピルカルバモイ ル基、ブチルカルバモイル基、 フェニルカルバモイル基等のカ ルバモイル基、カルボン酸基、 スルフォン酸基、イミド基、シ クロペンタン基、シクロヘキシ

ー (パーフルオロエチル) ヘキ Nitro phenylthio group; a p-tert-butyl phenylthio group, 3- fluoro phenylthio group, a pentafluoro phenylthio group, and 3- trifluoromethyl phenylthio group, Mono or di-substitution amino groups, such as cyano group, a nitro group, an amino group, a methyl-amino group, a diethylamino group, an ethylamino group, a diethylamino group, a dipropyl amino group, a dibutyl amino group, and a diphenyl amino group, Acylamino groups, such as a bis-(acetoxymethyl) amino group, a bis-(acetoxy ethyl) amino group, a bis-acetoxy propyl amino group, and a bis-(acetoxy butyl) amino group, Carbamovi groups, such as a hydroxyl group, a siloxy group, an acyl group, a methyl carbamoyl group, a dimethyl carbamoyl group, ethyl carbamoyl group, a diethyl carbamoyl group, a propyl carbamoyl group, a butyl carbamoyl ーフルオロフェニルチオ基、ペ group, and a phenyl carbamoyl group, cycloalkyl groups, such as a carboxylic-acid group, a sulfonic acid group, an imide group, a cyclopentane group, and a cyclohexyl group, A pyrrole group, a pyrroline group, a pyrazole group, a pyrazoline group, an imidazole group, a triazole group, a pyridine group, a pyridazine group, a pyrimidine group, a pyrazine group, a triazine group, an indole group, a purine group, a quinoline group, an isoquinoline group, a sinoline group, a quinoxaline group, a benzo quinoline group, a fluorenone group, a dicyano fluorene group, a carbazole group, an oxazole group, an oxadiazole group, a thiazole group, a thiadiazole group, a triazole group, an imidazole group, a benzoxazole group, a benzothiazole group, a benzotriazol group, a benzimidazole group, a bis- benzoxazole group, a bisbenzothiazole group, a bis- benzimidazole group, an anthrone group, a dibenzofuran group, an a dibenzo thiophene group, anthraquinone group, an acridone group, a phenothiazine group, a pyrrolidine group, a dioxane group, a piperidine group, a morpholine group, a piperazine group

There are heterocyclic groups, such as above, etc.

ル基等のシクロアルキル基、ピ ロール基、ピロリン基、ピラゾ ール基、ピラゾリン基、イミダ ゾール基、トリアゾール基、ピ リジン基、ピリダジン基、ピリ ミジン基、ピラジン基、トリア ジン基、インドール基、プリン 基、キノリン基、イソキノリン 基、シノリン基、キノキサリン 基、ベンゾキノリン基、フルオ・ レノン基、ジシアノフルオレン 基、カルバゾール基、オキサゾ ール基、オキサジアソール基、 チアゾール基、チアジアゾール 基、トリアゾール基、イミダゾ ール基、ベンゾオキサゾール基、 ベンゾチアゾール基、ベンゾト リアゾール基、ベンゾイミダゾ ール基、ビスベンゾオキサゾー ル基、ビスベンソチアゾール基、 ビスベンゾイミダゾール基、ア ントロン基、ジベンゾフラン基、 ジベンゾチオフェン基、アント ラキノン基、アクリドン基、フ ェノチアジン基、ピロリジン基、 ジオキサン基、ピペリジン基、 モルフォリン基、ピペラジン基 等の複素環基等がある。

#### [0015]

本発明における一般式 [1]及び一般式 [2]で示される化合物のA¹~A⁴およびA³~A²における置換もしくは未置換のアリール基としては、フェニル基、ゲフェニル基、アントリル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、プルオレニル基、ピレニル基等があり、置換もしくは未置換の複素プロリン基、ピラゾール基、ピラゾリ

#### [0015]

As the substituted or non-substituted aryl group in A1- A4 and A9-A12 of a compound, shown by the general formula [1] and the general formula [2] in this invention. There are a phenyl group, a biphenyl group, a terphenyl group, a naphthyl group, an anthryl group, a phenanthryl group, a fluorenyl group, a pyrenyl group, etc.

As a substituted or non-substituted heterocyclic group A pyrrole group, a pyrroline group, a pyrazole group, a pyrazoline group, an imidazole group, a triazole group, a pyridine group, a pyridine group, a pyrimidine group, a pyrazine group, a triazine group, an indole group, a purine group, a quinoline group, an

## DERWENT

#### THOMSON SCIENTIFIC

ン基、イミダゾール基、トリア ゾール基、ピリジン基、ピリダ ジン基、ピリミジン基、ピラジ ン基、トリアジン基、インドー ル基、プリン基、キノリン基、 イソキノリン基、シノリン基、 キノキサリン基、ベンゾキノリ ン基、フルオレノン基、カルバ ゾール基、オキサゾール基、オ キサジアゾール基、チアゾール 基、チアジアゾール基、トリア ゾール基、イミダゾール基、ベ ンソオキサソール基、ベンゾチ アゾール基、ベンゾトリアゾー ル基、ベンゾイミダゾール基、 ビスベンゾオキサゾール基、ビ スベンゾチアゾール基、ビスベ ンゾイミダゾール基、アントロ ン基、ジベンソフラン基、ジベ ンゾチオフェン基、アントラキ ノン基、アクリドン基、フェノ チアジン基、ピロリジン基、ジ オキサン基、モルフォリン基等 の複素環基等がある。また、 $A^1$ とA<sup>2</sup>もしくはA<sup>3</sup>とA<sup>4</sup>が互い に結合し環を形成してもよい。 A<sup>9</sup> ~ A<sup>12</sup> の置換もしくは未置 換のアリーレン基と置換むしく は未置換の2価の複素環基とし ては、上記アリール基または複 素環基の結合可能な任意の位置 に結合手を付けることによって 得られる基がある。また、A<sup>1</sup>~ A<sup>12</sup> の有する置換基としては上 記の乙に置換できる置換基が挙 げられる。

[0016]

本発明における一般式 [2] で示される $X^1 \sim X^4$ は、それぞれ独立に、-O-、-S-、>C=O、 $>SO_2$ 、>C=S、>

isoquinoline group, a sinoline group, A quinoxaline group, a benzo quinoline group, a fluorenone group, a carbazole group, an oxazole group, an oxadiazole group, a thiazole group, a thiadiazole group, a triazole group, an imidazole group, a benzoxazole group, a benzothiazole group, a benzothiazole group, A bis-benzoxazole group, a bis-benzothiazole group, a bis-benzimidazole group, a bis-benzimidazole group, an anthrone group, a dibenzofuran group, an dibenzo thiophene group, an anthraquinone group, an acridone group, a dioxane group, a morpholine group There are heterocyclic groups, such as above, etc.

Moreover, A1 and A2, or A3 and A4 may bond mutually, and they may form a ring.

As the substituted or non-substituted arylene group of A9-A12, and a substituted or non-substituted bivalent heterocyclic group they are group obtained by attaching a bond to the arbitrary positions which can bond an above aryl group or a heterocyclic group.

Moreover, as a substituent group which A1-A12 has, the substituent group which can be substituted by above-mentioned Z is

mentioned.

[0016]

X1- x4 shown by the general formula [2] in this invention, are independent respectively, -0-,-S-, >C=O, >SO2, and >C=S, >C= (CN) 2, >C=S=O, >C=N-CN, and >C=N-R1, (CH2) x-O-

 $C = (CN)_{2}, > C = S = O_{2}$ > C = N - C N, > C = N - R $^{1}$  (CH<sub>2</sub>),  $-O-(CH_{2})$ , 置換もしくは未置換のアルキレ ン基、置換もしくは未置換の複 素環基、置換もしくは未置換の シクロアルキレン基を表す。こ こでR1は、水素原子、ハロゲ ン原子、置換もしくは未置換の アリール基、置換もしくは未置 換のシクロアルキル基、置換も しくは未置換の複素環基を表 し、xおよびyは、それぞれ独 立に0~20の正の整数を表す が、x+y=0となることはな い。置換または未置換のアルキ レン基としては炭素数1~20 のアルキレン基もしくはその置 換体、置換または未置換のシク ロアルキレン基としては、シク ロペンチル基、シクロヘキシル 基、4-メチルシクロヘキシル 基、シクロヘプチル基等の炭素 数5~7のシクロアルキルの2 価の残基があげられる。置環基 の例としては、ハロゲン原子、 または上記記載のアミノ基、ア ルキル基、アリール基、シクロ アルキル基、アリールオキシ基、 アリールチオ基、複素環基等で あってもよい。X1~X4の置換 アルキレン基として好ましいも のは、2-フェニルイソプロピ レン基、ジクロロメチレン基、 ジフルオロメチレン基、ベンジ レン基、α-フェノキシベンジ レン基、 $\alpha$ ,  $\alpha$ ーメチルフェニ ルベンジレン基、ジフェニルベ ンジレン基、α-ベンジルオキ シベンジレン基などが挙げられ る。

(CH2) y, A substituted or non-substituted alkylene group, a substituted or non-substituted heterocyclic group, and a substituted or non-substituted cycloalkylene group are shown.

R1 shows a hydrogen atom, a halogen atom, a substituted or non-substituted aryl group, a substituted or non-substituted cycloalkyl group, and a substituted or non-substituted heterocyclic group here.

x and y respectively show the positive integer of 0-20 independently.

However, it does not become x+y=0.

As the alkylene group substituted or not alkylene group substituted. the 1-20C, As the substitution product of substituted not cycloalkylene group substituted, a cyclopentyl group, a cyclohexyl group, 4-methyl cyclohexyl group, the bivalent residue of C5-C7 cycloalkyls, such as a cyclo heptyl group, are raised.

As an example of a substituent group, it may be a halogen atom or an amino group described in above, an alkyl group, an aryl group, a cycloalkyl group, an aryloxy group, an arylthio group, a heterocyclic group, etc.

A thing desirable as a substituted alkylene group of X1- x4, 2- phenyl isopropylene group, dichloro methylene, difluoro methylene, a group benzylene,  $\alpha$ - phenoxy benzylene group  $\alpha$ ,  $\alpha$ - methyl phenylbenzylene a group, a diphenyl benzylene a group,  $\alpha$ - benzyl oxy benzylene group Above etc. are mentioned.

[0017]

以下に発光材料の代表例を表 2 に具体的に例示するが、以下の代表例に限定されるものではない。以下の代表例の発光層のイオン化ポテンシャルの値は 5.0~6.2 e V の範囲内の値である。

[0018]

【表2】

[0017]

The example of representation of a luminescent material is concretely illustrated to Table 2 below.

However, it is not limited to the following examples of representation.

The value of the ionization potential of the emitter layer of the following examples of representation is value within the range of 5.0-6.2eV.

[0018]

[Table 2]

£ 12 m 3	
【表2】 A-1	
A - 2	CH <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C
	H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>
	H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>
	ÇH <sub>3</sub> ÇH <sub>3</sub>
A - 3	ĞĞ
	$C_4H_7$ $N$ $N$ $C_4H_7$
A - 1	
	H <sub>3</sub> C CH <sub>8</sub>

[0019]

10019

【表2】	
A - 5	
A - 6	CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C-\rightarrow N-\rightarrow CH <sub>3</sub>
A - 7	H <sub>3</sub> C-CH <sub>3</sub>
A - 8	N-C=CH HC=C-CH HC=C-CH

[0020]

[0020]

[762]	
V 8	Q
	Ö
A 10	
A - 1 1	
	3,000

[0021]

[0021]

[長2]	
A 12	
A-13	
A-14	
A - 15	H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>
	H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>
	H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>

[0022]

*	•
【表2】	
A-16	
A-17	H <sub>3</sub> C N CH <sub>3</sub>
	H <sub>3</sub> C C N CCH <sub>3</sub>
A 18	H <sub>3</sub> C-CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>
A 19	

[0023]

[0023]

24/45

(表2)

(82)	
A 20	H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>
A 21	
A - 2 2	H <sub>3</sub> C-CH <sub>3</sub>

#### [0024]

正孔注入材料としては、正孔を 注入する能力を持ち、発光層ま たは発光材料に対して優れた正 孔注入効果を有し、発光層で生 成した励起子の電子注入層また は電子注入材料への移動を防止 し、かつ薄膜形成能の優れた化 合物が挙げられる。具体的には、 フタロシアニン系化合物、ナフ タロシアニン系化合物、ポルフ ィリン系化合物、オキサジアゾ ール、トリアブール、イミダブ ール、イミダゾロン、イミダゾ ールチオン、ピラゾリン、ピラ ゾロン、テトラヒドロイミダゾ ール、オキサゾール、オキサジ アゾール、ヒドラゾン、アシル

#### [0024]

As hole injection material, the compound which had the capability to inject a hole, had the emitter layer or the outstanding hole injection effect with respect to a luminescent material, and prevented the transfer to the electron injection layer or the electron injection material of an exciton generated by the emitter layer, and was outstanding in thin-film formation ability is mentioned.

phthalocyanine Specifically, Α compound, a naphthalo cyanine group compound, A porphyrins group compound, oxadiazole, a triazole, an imidazole, An imidazolone, an imidazole thione, a pyrazoline, a pyrazolone, the tetrahydro imidazole, An oxazole, oxadiazole, hydrazone, hydrazone, the poly aryl alkane, stilbene, a butadiene, benzidine type triphenylamine, stylyl amine type triphenylamine, diamine

# DERWENT THOMSON SCIENTIFIC

triphenylamine, etc., Those derivatives and polyvinyl carbazole, polysilane, Conductive polymer. There are macromolecular materials, such as above, etc.

However, it is not limited to these.

The example of representation of a useful hole injection material is illustrated concretely below in Table 3.

However, it is not limited to the following examples of representation.

[0025]

[0025]

【表3】

[Table 3]

1	4.	.,	1
1	v.	٠,	

【表3】		The state of the s
	IPle (e V)	化合物
		ÇH₃ H₃C(
B - 1	5.53	∠ (13°)
		_N-(>-N
	5 4 4	
B-2	5.40	<b>⟨¯⟩</b> _ <b>⟨_</b> ⟩
B 3	5.05	$H_3C N N N N N N N N$
İ		
		CH₃ CH₃ CH₃
B 4	5.13	
		CH <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C )
		H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>
		N-(_)-N_
	1	
		H <sub>3</sub> C, CH <sub>3</sub>
	į .	CH <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C
B 5	5.53	CH₃ CH₃
1.		
1	1	CH-N N-CH
}	1	C4H7-C4H7
1		
L	1	

[0026]

[0026]

[长3]		
	IP(ři	化合物
	(e V)	1
B 6		H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>
B-7	5.66	H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>
B - 8		
B 9	5.00	
[00	27]	[0027]

【表3】		
	IP(f)	化合物
	(e ÿ)	
B - 1 0		H <sub>3</sub> C
		N-(_)-E=C
		H <sub>3</sub> C′
В П		H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>
		N-()-C=C-()-N
		H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>
B-12		H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>
		H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>
		) O
B 13	5.10	
		H <sub>3</sub> C N
		CH3
1		l N
		CH <sub>3</sub>
1	1	

[0028]

[0028]

【表3】

【表3】		
	IP傾 (eV)	化合物
B - 1 4		銅フクロシアニン
B - 1 5		銅ナフクロシアニン
B 16		塩化インジウムフタロシアニン
B - 1.7		塩化アルミニウムフタロシアニン
B 18		ジクロロシリコンフタロシアニン
B 19		CH <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C
B - 2 0	5.60	H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>
B - 2 1	5.27	H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub> H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>

#### [0029]

01/06/01

電子注入材料としては、電子を 注入する能力を持ち、発光層 まは発光材料に対して優れた電 子注入効果を有し、発光層で生 成した励起子の正孔注入層また は正孔注入材料への移動を防止 し、かつ薄膜形成能の優れた化 ら物が挙げられる。例えば、フ ルオレノン、アントラキノジメ タン、ジフェノキノン、チオン ランジオキシド、オキサジアソ ール、チアジアソール、テトラ

#### [0029]

As electron injection material, the compound which had the capability to inject an electron, had the emitter layer or the outstanding electron injection effect with respect to a luminescent material, and prevented the transfer to the hole injection layer or the hole injection material of an exciton generated by the emitter layer, and was outstanding in thin-film formation ability is mentioned.

For example, fluorenone, anthraquino dimethane, a di-phenoquinone, a thio pyran dioxide, oxadiazole, a thiadiazole, the tetrazole, perylene tetracarboxylic acid, fluorenylidene methane, anthraquino dimethane, the anthrone,

ゾール、ペリレンテトラカルボン酸、フレオレニリデンメタン、アントラキノジメタン、アントロン、ヒドロキシキノリン金属策体化等とそれらの誘導体があるが、これらに限定されるものではない。以下に有用な電子注入材料の代表例を表3に具体的に例示するが、以下の代表例に限定されるものではない。

theformation of a hydroxyquinoline metal complex, and, etc. those derivatives exist.

However, it is not limited to these.

The example of representation of a useful electron injection material is illustrated concretely below in Table 3.

However, it is not limited to the following examples of representation.

[0030]

[0030]

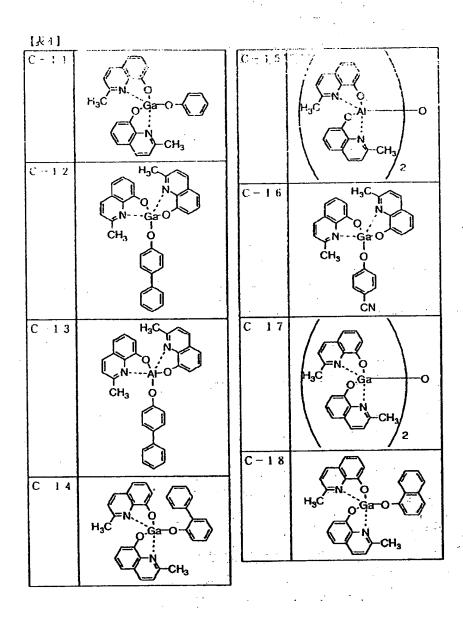
【表4】

[Table 4]

[304]		ود سند جديد ر	
C !		C 7	N A O N
C 2	O N Be O	C - 8	
C 3	O N Zi O N	6.0	O N
C - 4	N' 21 0-1	C-9	H <sub>9</sub> C N N A
C 5 .	N. O-	C-10	CH <sub>3</sub> ON CH <sub>3</sub>
C - 6		<b>C-10</b>	CH, O
L		) —	

[0031]

[0031]



[0032]

[0032]

(44)	
C 19	
C 20	
C-21	NC - N - N - N - N - N - N - N - N - N -
C - 2 2	$F = \begin{cases} N^{-N} & N^{-N} \\ N & N \\ N & N \end{cases}$ $C_2H_5 \qquad C_2H_5$
C - 23	NC $N$

[0033]

[0033]

<b>【八!</b>	
C - 24	
C - 25	N-N CF <sub>3</sub> N-N CF <sub>3</sub>
C 2 6	Para Para Para Para Para Para Para Para
	1-Bu
C - 27	
C - 2 8	OCH <sub>3</sub> CO

#### [0034]

#### [0034]

The thing with a work function larger than 4eV is suitable for the electroconductive material used for the anode of an organic EL element.

A carbon, aluminium, a vanadium, iron, cobalt, a nickel, tungsten, silver, gold, a platinum, a palladium, etc. And, oxidation metals, such as the stannic oxide called those alloys, ITO substrate, and NESA substrate and indium oxide, Furthermore organic conductive resins, such as the poly thiophene and a polypyrrole, are used.

The thing with a work function smaller than 4eV is suitable for the electroconductive material used for a cathode.

Those alloys, such as magnesium, calcium, tin, a lead, titanium yttrium, lithium, a ruthenium,

り小さな仕事関数を持つもの が好適であり、マグネシウム、 カルシウム、錫、鉛、チタニウ ム、イットリウム、リチウム、 ルテニウム、マンガン等および それらの合金が用いられるが、 これらに限定されるものでは ない。陽極および陰極は、必要 があれば二層以上の層構成に より形成されていても良い。

and manganese, are used.

However, it is not limited to these.

The anode and the cathode may be formed by the lamination more than a bilayer as long as there is need.

#### [0035]

有機EL素子では、効率良く発 光させるために、少なくとも一 方は素子の発光波長領域にお いて充分透明であることが望 ましい。また、基板も透明であ ることが望ましい。透明電極 は、上記の導電性材料を使用し て、蒸着やスパッタリング等の 方法で所定の透光性を確保す るように設定する。発光面の電 極は、光透過率を10%以上に することが望ましい。基板は、 機械的、熱的強度を有し、透明 であれば限定されるものでは ないが、例示すると、ガラス基 板、ポリエチレン板、ポリエー テルサルフォン板、ポリプロピ レン板等の透明性樹脂があげ られる。

#### [0036]

本発明に係わる有機EL素子 の各層の形成は、真空蒸着、ス パッタリング等の乾式成膜法 やスピンコーティング、ディッ ピング等の湿式成膜法のいず れの方法を適用することがで きる。膜厚は特に限定されるも のではないが、各層は適切な膜 厚に設定する必要がある。膜厚

#### [0035]

In an organic EL element, in order to make light emit efficiently, as for at least one is transparent enough in the light-emission wavelength area of an element, it is desirable.

Moreover, it is desirable that a substrate is also transparent.

A transparent electrode is set up so that the predetermined permeability in methods, such as vapour deposition and a sputtering, may be above-mentioned usina secured electroconductive material.

As for the electrode of a light-emission face, it is desirable to make the light transmittance into 10 % or more.

A substrate has mechanical and thermal strength.

It will not be limited if transparent.

However if it illustrates, Transparency resins, such as a glass substrate, a polyethylene board, polyether sulphone board, polypropylene board, are mentioned.

#### 100361

A formation of the each layer of the organic EL device in connection with this invention, Any method of wet film forming methods, such as dry type film forming methods, such as vacuum deposition and a sputtering, and spin coating, a dipping, etc., is applicable.

Especially a film thickness is not limited.

However, each layer needs to be set as a suitable film thickness.

If a film thickness is too thick, in order to

が厚すぎると、一定の光出力を 得るために大きな印加電圧が 必要になり効率が悪くなる。膜 厚が薄すぎるとピンホール等 が発生して、電界を印加しても 充分な発光輝度が得られない。 通常の膜厚は5nmから10 μmの範囲が好適であるが、1 0 n m から 0.2 μ m の範囲が さらに好ましい。

#### [0037]

湿式成膜法の場合、各層を形成 する材料を、クロロホルム、テ トラヒドロフラン、ジオキサン 等の適切な溶媒に溶解または 分散して薄膜を形成するが、そ の溶媒はいずれであっても良 い。また、いずれの薄膜におい ても、成膜性向上、膜のピンホ ール防止等のため適切な樹脂 や添加剤を使用しても良い。こ のような樹脂としては、ポリス チレン、ポリカーボネート、ポ リアリレート、ポリエステル、 ポリアミド、ポリウレタン、ポ リスルフォン、ポリメチルメタ クリレート、ポリメチルアクリ レート、セルロース等の絶縁性 樹脂、ポリーNービニルカルバ ゾール、ポリシラン等の光導電 性樹脂、ポリチオフェン、ポリ ピロール等の導電性樹脂を挙 げることができる。また、添加 剤としては、酸化防止剤、紫外 線吸収剤、可塑剤等を挙げるこ とができる。

#### [0038]

とも可能となる。発光層に使用。

obtain a fixed optical power, a large applied voltage will be needed and efficiency will become bad.

If a film thickness is too thin, a pinhole etc. generates. Even when it applies an electric field, sufficient light emission brightness is not obtained.

The range of 5 nm to 10 µm is suitable for the usual film thickness.

However, the range of 10 nm to 0.2 µm is more desirable.

#### [0037]

In the case of a wet film forming method, material which forms each layer is made into suitable solvent, such as chloroform, the tetrahydrofuran, and a dioxane, dissolution or dispersion, and a thin film is formed.

However, that solvent may be any.

Moreover, also in any thin film, a suitable resin and a suitable additive may be used for the forming property, improvement in film membranous pinhole prevention, etc.

As such resin, conductive resins, such as photoconductive resin, such as insulating resin, such as a polystyrene, a polycarbonate, a polyarvlate, polyester, a polyamide, polysulfone. polyurethane, polymethylmethacrylate, a polymethyl acrylate, and a cellulose, poly- N-vinylcarbazole, and the poly thiophene, and a polysilane, polypyrrole, can be mentioned.

Moreover, antioxidant, an ultraviolet absorber, a plasticizer, etc. can be mentioned as an additive agent.

#### [0038]

発光層にドーピング物質を使 A light-emission colour can also be changed to 用して発光色を変化させるこ an emitter layer using a doping material. As the doping material which can be used for an

できるドーピング物質として は、アントラセン、ナフタレン、 フェナントレン、ピレン、テト ラセン、コロネン、クリセン、 フルオレセイン、ペリレン、フ タロペリレン、ナフタロペリレ ン、ペリノン、フタロペリノン、 ナフタロペリノン、ジフェニル ブタジエン、テトラフェニルブ タジエン、クマリン、オキサジ アゾール、アルダジン、ビスベ ンゾキサゾリン、ビススチリ ル、ピラジン、シクロペンタジ エン、キノリン金属錯体、アミ ノキノリン金属錯体、イミン、 ジフェニルエチレン、ビニルア ントラセン、ジアミノカルバゾ ール、ピラン、チオピラン、ポ リメチン、メロシアニン、イミ ダゾールキレート化オキシノ イド化合物、キナクリドン、金 属フタロシアニン、ルブレン等 およびそれらの誘導体がある が、これらに限定されるもので はない。

[0039]

本発明により得られた有機E L素子の、温度、湿度、雰囲気 等に対する安定性の向上のた めに、素子の表面に保護層を設 けたり、シリコンオイル等を封 入して素子全体を保護するこ とも可能である。

[0040]

【実施例】

以下、本発明を実施例に基づき さらに詳細に説明する。 実施例 1

emitter layer An anthracene, a naphthalene, a phenanthrene, a pyrene, a tetracene, coronene, chrysene, the fluorescin, a perylene, a phthal perylene, a naphthalo perylene, perinone, phthal perinone, naphthalo perinone, a diphenyl butadiene, A tetraphenyl butadiene, coumarin, oxadiazole, aldazine, bis benzo oxazoline, а bis styryl, а pyrazine, cyclopentadiene, a quinoline metal complex, an amino quinoline metal complex, an imine, a diphenylethylene, a vinyl anthracene, diamino carbazole, the pyran, the thio pyran, the poly methine, merocyanine, an imidazole chelation oxynoid compound, a quinacridone, metal phthalocyanine, rubrene Those derivatives, such as above, exist.

However, it is not limited to these.

[0039]

A protective layer is provided on the surface of an element for the improvement in the stability with respect to the temperature of the organic EL device obtained by this invention, humidity, and atmosphere etc.

Moreover, it is also possible to seal silicon oil etc. and to protect the entire element.

[0040]

[Example]

Hereafter, this invention is explained more in detail based on an example.

Example 1

On the pane of glass with washed ITO

洗浄したITO電極付きガラ ス板上に、化合物(B-14) を真空蒸着して、膜厚20mm の第一正孔注入層を作製した。 さらに、化合物(B-2)を真 空蒸着して、膜厚20mmの第 二正孔輸送層を作製した。次い で、化合物(A-3)を真空蒸 着して膜厚30nmの発光層 を作成し、化合物(C-1)を 真空蒸着して膜厚40mmの 電子注入層を作製した。その上 に、マグネシウムと銀を10: 1で混合した合金で膜厚10 Onmの電極を形成して有機 EL素子を得た。正孔注入層お よび発光層は10°Torrの 真空中で、基板温度室温の条件 下で蒸着した。この素子は、直 流電圧10Vで約8000c d/m²の発光が得られた。こ の素子を25mA/cm2の 電流密度において低電流駆動 させたところ、発光輝度200 c d/m² を示した。40時間 経過後でも120cd/m<sup>2</sup>の 高輝度を示した。このとき IT O電極の I P値は4. 95 e V、第一正孔注入層の I P値は 5.05eV、第二正孔注入層 の I P値は 5. 40 e V、発光 層のIP値は5.53eVであ り請求項1記載の関係式を満 足する。

[0041]

比較例1

正孔注入層B-14を省略した以外、実施例1と同様に有機 EL素子を作製し、正孔注入層が1層の素子を作製した。ただし、正孔注入層B-2の膜厚を

electrode, the vacuum evaporation of the compound (B-14) was performed, and the first hole injection layer of 20 nm film thickness was produced.

Furthermore, the vacuum evaporation of the compound (B-2) was performed, and the second hole carrying layer of 20 nm film thickness was produced.

Subsequently, the vacuum evaporation of the compound (A-3) is performed, and the emitter layer of 30 nm film thickness is produced. The vacuum evaporation of the compound (C-1) was performed, and the electron injection layer of 40 nm film thickness was produced.

On it, the electrode of 100 nm film thickness was formed with the alloy which mixed magnesium and silver by 10:1, and the organic EL element was obtained.

The hole injection layer and the emitter layer were deposited on condition that the substrate-temperature room temperature in the vacuum of 10-6 Torr.

As for this element, about 8000-cd/m2 light emission was obtained by DC-voltage 10V.

The light-emission brightness of 200 cd/m2 was shown when performed the low current drive of this element in the current density of 25mA/cm2.

The 120-cd/m2 high-intensity was shown also after the 40 hour.

At this time, IP value of ITO electrode is 4.95eV. IP value of a first hole injection layer is 5.05eV. IP value of a second hole injection layer is 5.40eV. IP value of an emitter layer is 5.53eV. The relation of Claim 1 is satisfied.

#### [0041]

Comparative Example 1

39/45

An organic EL element is produced as an example 1 except having abbreviated the hole injection layer B-14.

The hole injection layer produced the element of 1 layer.

However, the film thickn ss of the hole

 $40 \, \text{nm} \text{b}$  した。この場合、この素子を $25 \, \text{mA/cm}^2$  の電流密度において低電流駆動させたところ、発光輝度 $900 \, \text{c}$  d/m² を示したが、 $40 \, \text{時間経過後では、} 200 \, \text{c}$  d/m² を著しく輝度の低下が激しく、耐久性が劣っていた。このことから、複数層の正孔注入層が存在する場合、耐久性の向上に効果があることが分かる。

### [0042]

実施例2

洗浄したITO電極付きガラ ス板上に、化合物(B-14) を真空蒸着して、膜厚30nm の第一正孔注入層を作製した。 さらに、化合物(B-21)を 真空蒸着して、膜厚20mmの 第二正孔注入層を作製し、化合 物 (B-2) を真空蒸着して、 膜厚20nmの第三正孔注入 層を作製した。。次いで、化合 物(A-3)を真空蒸着して膜 厚30nmの発光層を作成し、 化合物(C-13)を真空蒸着 して膜厚40nmの電子注入 層を作製した。その上に、マグ ネシウムと銀を10:1で混合 した合金で膜厚100mmの 電極を形成して有機EL素子 を得た。正孔注入層および発光 層は10mmの真空中 で、基板温度室温の条件下で蒸 着した。この素子は、直流電圧 10 Vで約10000 c d/ m²の発光が得られた。この素 子を25mA/cm2の電流 密度において低電流駆動させ たところ、発光輝度250cd /m² を示した。40時間経過

injection layer B-2 was set to 40 nm.

In this case, the light-emission brightness of 900 cd/m2 was shown when performed the low current drive of this element in the current density of 25mA/cm2.

However, after the 40 hour, a reduction of a brightness is remarkably as intense as 200 cd/m<sup>2</sup>. The endurance was inferior.

When a multiple layered hole injection layer is present from this, a durable improvement understands that it is effective.

#### [0042]

Example 2

On the pane of glass with washed ITO electrode, the vacuum evaporation of the compound (B-14) was performed, and the first hole injection layer of 30 nm film thickness was produced.

Furthermore, the vacuum evaporation of the compound (B-21) is performed.

The second hole injection layer of 20 nm film thickness is produced.

The vacuum evaporation of the compound (B-2) was performed, and the third-hole injection layer of 20 nm film thickness was produced.

Subsequently, the vacuum evaporation of the compound (A-3) is performed, and the emitter layer of 30 nm film thickness was produced, the vacuum evaporation of the compound (C-13) was performed, and the electron injection layer of 40 nm film thickness was produced.

On it, the electrode of 100 nm film thickness was formed with the alloy which mixed magnesium and silver by 10:1, and the organic EL element was obtained.

The hole injection layer and the emitter layer were deposited on condition that the substrate-temperature room temperature in the vacuum of 10-6 Torr.

As for this element, about 10000-cd/m2 light emission was obtained by DC-voltage 10V.

The light-emission brightness of 250 cd/m2 was shown when performed the low current drive of this element in the current density of

後でも180cd/m²の高輝度を示した。このときITO電極のIP値は4.95eV、第一正孔注入層のIP値は5.05eV、第二正孔注入層のIP値は5.27eV、第三正孔注入層のIP値は5.25eV、発光層のIP値は5.53eVであり請求項1記載の関係式を満足する。

#### [0043]

#### 実施例3

洗浄したITO電極付きガラ ス板上に、化合物(B-3)を 真空蒸着して、膜厚30nmの 第一正孔注入層を作製した。さ らに、化合物 (B-2) を真空 蒸着して、膜厚20nmの第二 正孔輸送層を作製した。次い で、化合物(A-2)を真空蒸 着して膜厚30nmの発光層 を作成し、化合物 (C-11) を真空蒸着して膜厚40nm の電子注入層を作製した。その 上に、マグネシウムと銀を1 0:1で混合した合金で膜厚1 00nmの電極を形成して有 機EL素子を得た。正孔注入層 および発光層は10°Torr の真空中で、基板温度室温の条 件下で蒸着した。この素子は、 直流電圧10Vで約7000 O c d/m² の発光が得られ た。この素子を25mA/cm 2の電流密度において低電流駆 動させたところ、発光輝度10 00 c d/m<sup>2</sup>を示した。40 時間経過後でも700cd/ m²の高輝度を示した。このと きITO電極のIP値は4.9 5 e V、第一正孔注入層の I P

25mA/cm2.

The 180-cd/m2 high-intensity was shown also after the 40 hour.

At this time, IP value of ITO electrode is 4.95eV. IP value of a first hole injection layer is 5.05eV. IP value of a second hole injection layer is 5.27eV. IP value of the third-hole injection layer is 5.05eV. IP value of an emitter layer is 5.53eV. The relation of Claim 1 is satisfied.

#### [0043]

#### Example 3

On the pane of glass with washed ITO electrode, the vacuum evaporation of the compound (B-3) was performed, and the first hole injection layer of 30 nm film thickness was produced.

Furthermore, the vacuum evaporation of the compound (B-2) was performed, and the second hole carrying layer of 20 nm film thickness was produced.

Subsequently, the vacuum evaporation of the compound (A-2) is performed, and the emitter layer of 30 nm film thickness was produced, the vacuum evaporation of the compound (C-11) was performed, and the electron injection layer of 40 nm film thickness was produced.

On it, the electrode of 100 nm film thickness was formed with the alloy which mixed magnesium and silver by 10:1, and the organic EL element was obtained.

The hole injection layer and the emitter layer were deposited on condition that the substrate-temperature room temperature in the vacuum of 10-6 Torr.

As for this element, about 70000-cd/m2 light emission was obtained by DC-voltage 10V.

The light-emission brightness of 1000 cd/m2 was shown when performed the low current drive of this element in the current density of 25mA/cm2.

The 700-cd/m2 high-intensity was shown also after the 40 hour.

At this time, IP value of ITO electrode is 4.95eV. IP value of a first hole injection layer is

入層の I P値は 5. 40 e V 、 発光層の I P値は5.61e V であり請求項1記載の関係式 を満足する。

値は5.05eV、第二正孔注 5.05eV. IP value of a second hole injection layer is 5.40eV. IP value of an emitter layer is 5.61eV. The relation of Claim 1 is satisfied.

#### [0044]

#### 比較例2

第一正孔注入層として化合物 (B-2)を第二正孔輸送層と して化合物(B-3)を用いた 以外、実施例3と同様に有機E L素子を作製した。この素子を 25mA/cm²の電流密度に おいて低電流駆動させたとこ ろ、発光輝度600cd/m<sup>2</sup> を示したが、40時間経過後で も70cd/m2の輝度しか得 られず、耐久性が著しく劣って いた。

#### [0045]

#### 実施例4

第一正孔注入層を化合物(B-13) に変える以外は、実施例 3と同様に素子を作製した。こ の素子は、直流電圧10Vで約 80000cd/m²の発光が 得られた。この素子を25mA /cm<sup>2</sup>の電流密度において低 電流駆動させたところ、発光輝 度1200cd/m<sup>2</sup>を示し た。40時間経過後でも900 cd/m²の高輝度を示した。 このときITO電極のIP値 は4.95eV、第一正孔注入 層の I P値は 5. 10 e V、第 二正孔注入層の I P値は5.4 0eV、発光層のIP値は5. 61eVであり請求項1記載 の関係式を満足する。

#### [0044]

#### Comparative Example 2

The organic EL element was produced as the example 3 except having used the compound (B-3) as a first hole injection layer, having used the compound (B-2) as the second hole carrying laver.

The light-emission brightness of 600 cd/m2 was shown when performed the low current drive of this element in the current density of 25mA/cm2.

However, only the brightness of 70 cd/m2 is obtained even after the 40 hour. The endurance was remarkably inferior.

#### [0045]

#### Example 4

The element was produced as the example 3 except changing a first hole injection layer into a compound (B-13).

As for this element, about 80000-cd/m2 light emission was obtained by DC-voltage 10V.

The light-emission brightness of 1200 cd/m2 was shown when performed the low current drive of this element in the current density of 25mA/cm2.

The 900-cd/m2 high-intensity was shown also after the 40 hour.

At this time, IP value of ITO electrode is 4.95eV. IP value of a first hole injection layer is 5.10eV. IP value of a second hole injection layer is 5.40eV. IP value of an emitter layer is 5.61eV. The relation of Claim 1 is satisfied.

#### [0046]

#### 実施例5

第二正孔注入層を化合物(B-5) に変える以外は、実施例3 と同様に素子を作製した。この 素子は、直流電圧10Vで約6 5000cd/m²の発光が得 られた。この素子を25mA/ cm²の電流密度において低電 流駆動させたところ、発光輝度 900cd/m<sup>2</sup>を示した。4 0時間経過後でも650cd /m² の高輝度を示した。この ときITO電極のIP値は4. 95eV、第一正孔注入層の I P値は5.05eV、第二正孔 注入層のIP値は5.53 e V、発光層のIP値は5.61 e Vであり請求項1記載の関 係式を満足する。

#### [0047]

#### 実施例6

01/06/01

第一正孔注入層を化合物(B-4) に変える以外は、実施例3 と同様に素子を作製した。この 素子は、直流電圧10Vで約7 5000cd/m²の発光が得 られた。この素子を25mA/ cm²の電流密度において低電 流駆動させたところ、発光輝度 1100 c d/m<sup>2</sup> を示した。 40時間経過後でも1000 cd/m²の高輝度を示した。 このときITO電極のIP値 は4.95eV、第一正孔注入 層のIP値は5.13eV、第 二正孔注入層のIP値は5.4 OeV、発光層のIP値は5. 61eVであり請求項1記載 の関係式を満足する。

#### [0046]

#### Example 5

The element was produced as the example 3 except changing a second hole injection layer into a compound (B-5).

As for this element, about 65000-cd/m2 light emission was obtained by DC-voltage 10V.

The light-emission brightness of 900 cd/m2 was shown when performed the low current drive of this element in the current density of 25mA/cm2.

The 650-cd/m2 high-intensity was shown also after the 40 hour.

At this time, IP value of ITO electrode is 4.95eV. IP value of a first hole injection layer is 5.05eV. IP value of a second hole injection layer is 5.53eV. IP value of an emitter layer is 5.61eV. The relation of Claim 1 is satisfied.

#### [0047]

#### Example 6

The element was produced as the example 3 except changing a first hole injection layer into a compound (B-4). ð.

As for this element, about 75000-cd/m2 light emission was obtained by DC-voltage 10V.

The light-emission brightness of 1100 cd/m2 was shown when performed the low current drive of this element in the current density of 25mA/cm2.

The 1000-cd/m2 high-intensity was shown also after the 40 hour.

At this time, IP value of ITO electrode is 4.95eV. IP value of a first hole injection layer is 5.13eV. IP value of a second hole injection layeris 5.40eV. IP value of an emitter layer is 5.61eV. The relation of Claim 1 is satisfied.

[0048]

実施例7

発光層を化合物(A-21)に 変える以外は、実施例4と同様 に素子を作製した。この素子 は、直流電圧10Vで約200 O c d / m² の発光が得られ た。この素子を25mA/cm <sup>2</sup>の電流密度において低電流駆 動させたところ、発光輝度10 0 c d/m<sup>2</sup>を示した。40時 間経過後でも80cd/m²の 輝度を示した。このときITO 電極のIP値は4.95eV、 第一正孔注入層の I P値は5. 10 e V、第二正孔注入層の I P値は5. 40eV、発光層の I P値は5. 70 e Vであり請 求項1記載の関係式を満足す る。

[0049]

#### 【発明の効果】

本発明により、従来に比べて陽極から発光層へのホール注入障壁を低下することができるため、ジュール熱の発生を低減でき、有機EL素子の耐久性の向上を図ることが可能となった。

[0048]

Example 7

The element was produced as the example 4 except changing an emitter layer into a compound (A-21).

As for this element, about 2000-cd/m2 light emission was obtained by DC-voltage 10V.

The light-emission brightness of 100 cd/m2 was shown when performed the low current drive of this element in the current density of 25mA/cm2.

The brightness of 80 cd/m2 was shown also after the 40 hour.

At this time, IP value of ITO electrode is 4.95eV. IP value of a first hole injection layer is 5.10eV. IP value of a second hole injection layer is 5.40eV. IP value of an emitter layer is 5.70eV. The relation of Claim 1 is satisfied.

[0049

#### [EFFECT OF THE INVENTION]

By this invention, the hole injection barrier from an anode to an emitter layer can be reduced compared with the grior art. Therefore, generation of a Joule hear can be reduced.

The durable improvement of an organic EL element can be achieved now.



#### **DERWENT TERMS AND CONDITIONS**

Derwent shall not in any circumstances be liable or responsible for the completeness or accuracy of any Derwent translation and will not be liable for any direct, indirect, consequential or economic loss or loss of profit resulting directly or indirectly from the use of any translation by any customer.

Derwent Information Ltd. is part of The Thomson Corporation

Please visit our home page:

"WWW.DERWENT.CO.UK" (English)
"WWW.DERWENT.CO.JP" (Japanese)